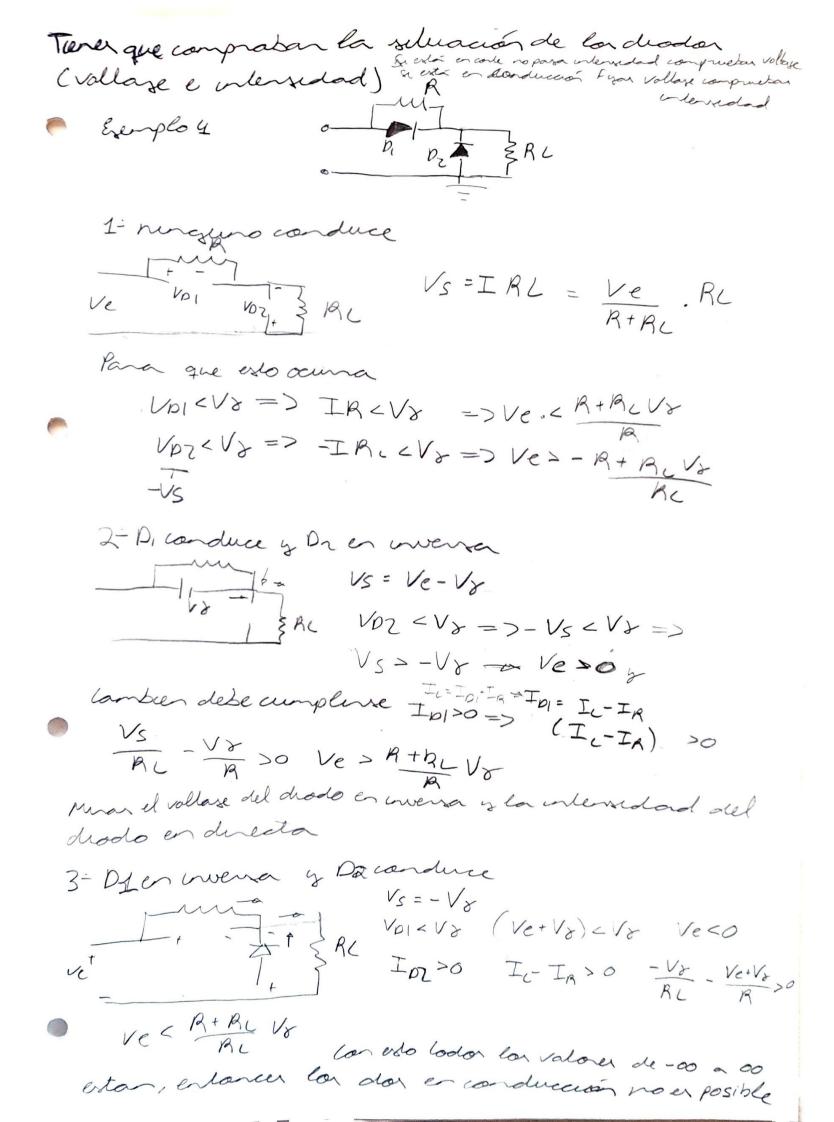


Esercicio deleveran el punto de polarización de los dodor R=19KI, R=4KI suponer para ambor una lension ideal Depende del vollage en X, 10V B 1/2 N 3V Si XLIOV - Di en dereda y Dz en unersa, x x>10 - ambon a uversa, si X < 3 - antos conduces Panece raxonable consideran D, en dueda y Dr en invene probanar sustituisendo las diodas por las modelas correspondera 10 min 1 3 36KS IDIR+V8+IDI-6KS1-10V=0 IpiR+Ipi6K9=10-V& Ipi (R16)=10-V& Ipi= 10-V& R+6 @ Pana R:= 19KS - Ipi= 376.10-46Pana R:=4KSZ - Ipi=94.104 Vp = Io1.6KI @Vp = 2/256 V 5 Vp = 584V Para el caso @, el vollage de ambor diodor est y por Conlo conducen la que quire clean que la répotesir es Folsa, para el 5 en cambio si que cumple la repoteses Para el @ planteamor una nueva hipóteria 10 W X= 3-V8 = 24 IDI = V = 10 - V8 - 24 = 0388 maso IDZ = IDI-IR = 0'368-VP For lands la hypoterin es conecta



ancietos recordadores IDR + VD + VBI - Vi =0 IDR+VD+VBI = Vi -V Up. To Doorduce Ono canduce Vn+VB=Vo Vi 16 VB+Va necorta la seral VB+V8 Vi Vp=V3, Ip=0 Si V, <- V>-VB Decorduce Vo=- Vz-Vp St. N. 7-12-12 1) noborduce Vo= V

Reducación de diodos 2 (ason D, en voersa o en auer
Re 1:D, en duerta 25 | Vs = Ve(t)-Vs

Re 1:D, en duerta 25 | Vs = Ve(t)-Vs

Re 2- D, en voerser V(s)=0  $V_D < V_{\delta} = > V_e(t) < V_{\delta}$ Suponendo Vs=0'7 De esta forma en las parles en las que el vollage de entrada es negativo tereno o a la salida nunca has voltage regatio Rega, disapravecha semuda negativa hexinen - Dradade unión es un semiconductor de dos terminales de comportamento no livial, que conduce de forma apreciable en un único sentido cuando entre sur Cerminales se alcama un valor combral - Se puede oblever su punto de trabaso graficamente a, partir del corte entre la canacterística del diodo y la recla de canaca - Se hala con her modelor aproxunador, interruptor, t unbral y resistencia duránica Diodo teren en dueda se comporta como un diado de unión, pero en inversa presenta también una región de conducción llava de ruptura El sed y el folododo son diador de unas p-n

harrestor bipolar de unión - La comente volo puede uncular en dichor sentidos of vertua Knetoff IB+IC=IE VEB+VBE=VCE La unión base-envior se comporter de Fo à la de un diodo In Ic IE VEE VAG 0 0 × 60'5-06V >0 BIB (1-13)IB ≥01SV ~05~06V relie Saluradión >0 < BIB < (1+B) IB = 0'15 ~0'5-06V Modelo lineal apraximado Ic IE VCE < V2 0 Indet BIO (HA)ID EVER, Set Activa = Vx = 1/2 Saluración >0 <BIB (1.0) = Veisat Corle Bare | Colector Nelwan VBE,8 Hay que compraba: VBE, & Half que compradon Hour are comp VBEZVY In>O y VCE > VCE, sat IDO ICEBID

U

Transistor bipolar de unión
To PIE
npn $pnp$
- Se comenie volo puede uncular en dichor sentidor se ventua Knetroff IB+Ic=IE VCB+VBE=VCE
La unión base-envor se comporta de Forma sinda a la de un diodo
Corle To Ic IE VEE VBE 000 X COS-06V
Notwer >0 BIB (1+B)IB ≥015V ~05~06V Saluration >0 <bib <(1+b)ib="" td="" ~05-06v<="" ≤015=""></bib>
Modelo lineal apraximado
Corte 0 0 0 mdet < Vs Activa >0 BIB (HA)IB 2 VEE, Set = Vs Salunación >0 < BIB (HO)IB = VEE Sat = Vs
Corle Bare   Colector Active   BIB Saturación   VCE Sat   VBE, 8   TB>O y VCE > VCE, sat   IB>O Ic < BIB